【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成22年4月22日(2010.4.22)

【公開番号】特開2009-47718(P2009-47718A)
【公開日】平成21年3月5日(2009.3.5)
【年通号数】公開・登録公報2009-009
【出願番号】特願2007-210741(P2007-210741)
【国際特許分類】
Ｇ０９Ｇ　3/30　(2006.01)
Ｇ０９Ｇ　3/20　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　51/50　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｇ０９Ｇ　3/30　Ｊ
Ｇ０９Ｇ　3/20　６２４Ｂ
Ｇ０９Ｇ　3/20　６２１Ｍ
Ｇ０９Ｇ　3/20　６１１Ｈ
Ｇ０９Ｇ　3/20　６４２Ａ
Ｈ０５Ｂ　33/14　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成22年3月5日(2010.3.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４９】
［期間－ＴＰ（３）$_3$］（図９参照）
その後、第１ノード初期化トランジスタ制御回路１０４の動作に基づき、第１ノード初期化トランジスタ制御線AZ_{ND1}をローレベルとすることによって、第１ノード初期化トランジスタT_{ND1}をオフ状態とする。その結果、第１ノードND_1の電位は変化せず（V_{Ofs}＝０ボルトを維持）、浮遊状態の第２ノードND_2の電位も変化せず、（$V_{Ofs}-V_{th}$＝－３ボルト）を保持する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１６５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１６５】
T_{Sig}・・・映像信号書込みトランジスタ、T_{Drv}・・・駆動トランジスタ、T_{EL_C}・・・発光制御トランジスタ、T_{ND1}・・・第１ノード初期化トランジスタ、T_{ND2}・・・第２ノード初期化トランジスタ、C_1・・・コンデンサ部、ＥＬＰ・・・有機エレクトロルミネッセンス発光部（発光部）、C_{EL}・・・発光部ＥＬＰの寄生容量、ND_1・・・第１ノード、ND_2・・・第２ノード、ＳＣＬ・・・走査線、ＤＴＬ・・・データ線、CL_{EL_C}・・・発光制御トランジスタ制御線、AZ_{ND1}・・・第１ノード初期化トランジスタ制御線、AZ_{ND2}・・・第２ノード初期化トランジスタ制御線、LD_1・・・ＬＤＤ構造（第１のＬＤＤ構造）、LD_2・・・第２のＬＤＤ構造、１０・・・有機エレクトロルミネッセンス素子、２０・・・支持体、２１・・・基板、３１・・・ゲート電極、３２・・・ゲート絶縁層、３３・・・半導体層、３４・・・チャネル形成領域、３５，35_1，35_2・・・

ソース／ドレイン領域、３６・・・他方の電極、３７・・・一方の電極、３８，３９・・・配線、４０・・・層間絶縁層、５１・・・アノード電極、５２・・・正孔輸送層、発光層及び電子輸送層、５３・・・カソード電極、５４・・・第２層間絶縁層、５５，５６・・・コンタクトホール、１００・・・電源部、１０１・・・走査回路、１０２・・・映像信号出力回路、１０３・・・発光制御トランジスタ制御回路、１０４・・・第１ノード初期化トランジスタ制御回路、１０５・・・第２ノード初期化トランジスタ制御回路